



SiC MOSFET 1700V Product Line Extension (750 mOhm in TO-263-7L package)

Littelfuse erweitert sein Programm der SiC-MOSFETs mit dem neuen 1700V, 750mOhm Baustein. Der Chip wird im TO-263-7L-Gehäuse verpackt. Durch den Kelvin-Kontakt wird die parasitäre Source-Induktivität zum Treiber deutlich reduziert. Dadurch kann der Wirkungsgrad speziell in Hochleistungsanwendungen deutlich verbessert werden. Die maximal zulässige Sperrschichttemperatur beträgt 175 °C.

Produktmerkmale

- Optimiert für Hochfrequenz-Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad
- Äußerst geringe Gate-Ladung und Ausgangskapazität
- Niedriger Gate-Widerstand für hochfrequentes Schalten
- Normally-off-Betrieb bei allen Temperaturen
- Ultra-niedriger On-Widerstand
- Optimiertes Gehäuse mit Kelvin-Kontakt
- MSL 1 Grad

Muster sind verfügbar – bei Interesse sprechen Sie uns bitte an.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: <https://www.hg-electronics.de>